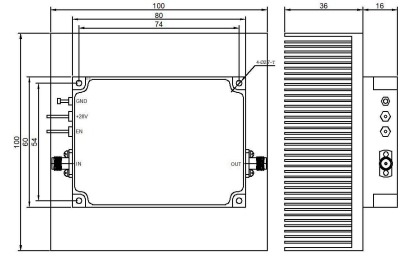


30–1000 MHz GaN RF güç yükselteci, tipik 10 W

GaN yükselteç 30–1000 MHz bandında en az 9 W ve tipik 10 W doygun çıkış sağlar. Tipik kazanç 40 dB, düzlüğü ± 1 dB; 10 W çıkışta tipik akım 0.6 A'dır.



Elektriksel özellikler · +28.0VDC; 25°C; 50Ω

Parametre	Sembol	Minimum	Tipik	Maksimum	Birim
Çalışma frekansı	BW	30	-	1000	MHz
RF çıkış gücü @ PSAT	PSAT	9	10	-	W
Güç kazancı @ PSAT	Gp	-	40	-	dB
Güç kazancı düzlüğü @ PSAT	ΔGp	-	± 1	-	dB
Giriş geri dönüş kaybı	S11	-	-15	-	dB
10 W'ta Harmonikler	H	-	-12	-	dBc
İstenmeyen sinyaller @ PSAT	Spur	-	-60	-	dBc
Giriş/çıkış empedansı	Impedance	-	50	-	Ω
Çalışma gerilimi	VDC	-	28	-	VDC
DC akımı @ 10W	IDD	-	0.6	-	A

Mutlak maksimum değerler

Parametre	Nominal değer
Hasarsız RF giriş gücü	+5 dBm en çok
Pout = 10 W'ta Yük VSWR	5:1; Tüm yük fazları ve genlikleri; sürekli
Termal aşırı yük	85 °C → Kapanma (en çok)

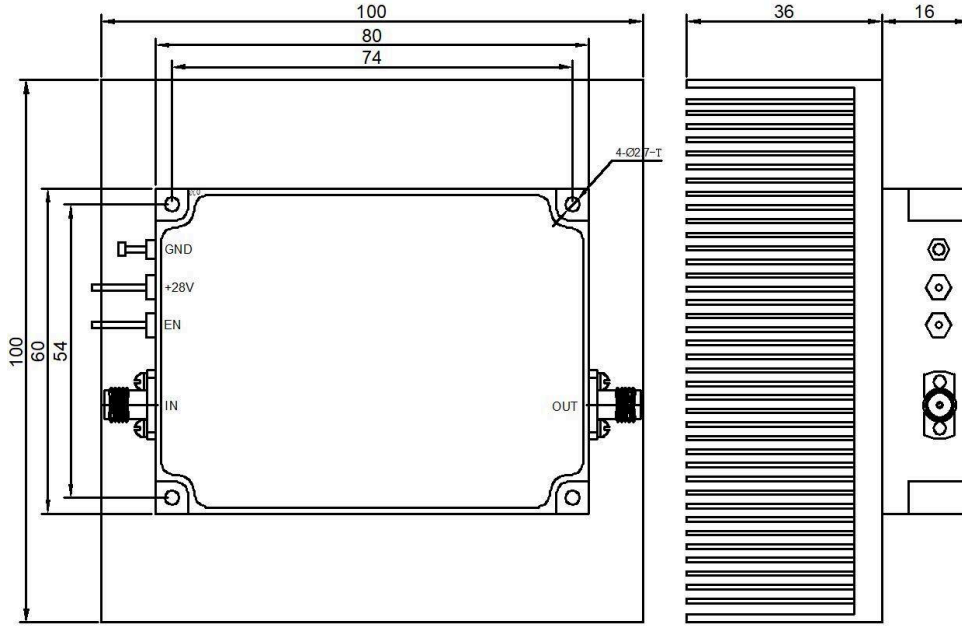
Çevresel özellikler · Tasarım hedefleri; proje kapsamında doğrulanmalıdır

Parametre	Minimum	Tipik	Maksimum	Birim	Notlar
Çalışma sıcaklığı	-20	-	50	°C	-
Depolama sıcaklığı	-25	-	65	°C	Depolama sıcaklığı
Bağıl nem (yoğuşmasız)	-	-	95	%	-

Mekanik özellikler

Parametre	Değer	Birim
Boyutlar	100 × 100 × 52[3.94 × 3.94 × 2.05] mm [in]	mm [in]
Ağırlık	2.5 kg (tipik)	kg
RF giriş konnektörü	SMA, dişi	-
RF çıkış konnektörü	SMA, dişi	-
DC/kontrol arayüzü	Geçiş pini	-
Toprak konnektörü	Toprak pini	-

Mekanik ölçü çizimi



Tüm ölçüler mm [in] cinsindendir.

DC ve Kontrol Arayüzü

Pin no.	Açıklama	Teknik değer
+28V	+28V — Pozitif besleme	+28 VDC
GND	GND — Toprak	Toprak
EN	EN — Etkinleştirme	TTL yüksek seviye (3.3 V); dahili aşağı çekme

Belge notu

Teknik özellikler revize edilebilir. Tasarımı kesinleştirmeden önce güncel belge revizyonunu ve ürüne özel gereksinimleri LCRF ile doğrulayın. Onaylı teklif ve sipariş belgeleri tedarik edilen yapılandırmayı tanımlar.